LAPT 2SA1386/1386A

シリコンPNPエピタキシャルプレーナ型トランジスタ (2SC3519/3519Aとコンプリメンタリ)

プコンFNFエピタインヤルフレーテ型 Fフンシスタ (2003519/3519ACコンフリスフタリ

記号 規格値 2SA1386 2SA1386A 単位 VCBO - 160 - 180 V VCEO - 160 - 180 V VEBO - 5 V Ic - 15 A

130(Tc = 25)

150 - 55 ~ + 150

絶対最大定格

Iв Рс

Τj

Tstg

単 位	
V	_
V	
V	
Α	-
Α	1
W	_
	-
	_

(Ta = 25)

電気	的	持性
----	---	----

(Ta = 25) 規格値

試験条件	規:	単位		
	ホート	2SA1386	2SA1386A	平 四
		- 100max	- 100max	μA
	V _{CB} =	- 160	- 180	V
VEB :	= - 5V	- 10	μA	
Ic = -	- 25mA	- 160min	- 180min	V
VcE = - 4	V, Ic = - 5A	50		
Ic = - 5A,	I _B = - 0.5A	- 2.0	V	
Vce = - 1	2V, IE = 2A	40typ		MHz
VcB = - 10)V, f = 1MHz	50	pF	
	VEB: IC = - VCE = - 4 IC = - 5A, VCE = - 1		SE	SA1386 SA1386A CA1386A CA13

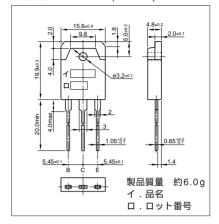
代表的スイッチング特性(エミッタ接地)

ランク O(50~100), P(70~140), Y(90~180)

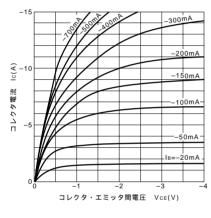
一人役のスイッチング行任(エミック技地)					5)		,, (,, , , , ,		
	Vcc (V)	Rι (Ω)	Ic (A)	VBB1 (V)	VBB2 (V)	I _{B1} (A)	IB2 (A)	ton (µs)	tstg (µs)	tf (µs)
	-40	4	-10	-10	5	-1	1	0.3typ	0.7typ	0.2typ

用途:オーディオ、一般用

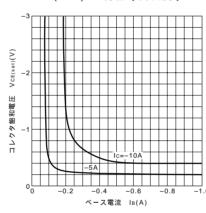
外形図 MT-100(TO3P)



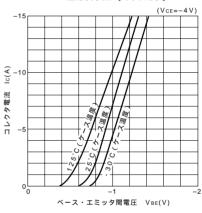
Ic-Vc∈特性(代表例)



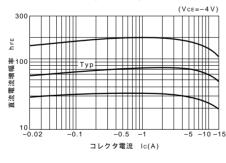
Vce(sat)-IB特性(代表例)



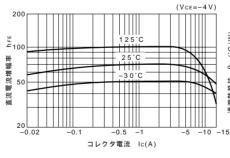
Ic-VBE温度特性(代表例)



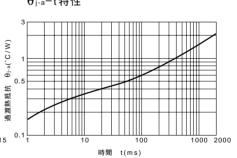
hғ₌−Ic特性(代表例)



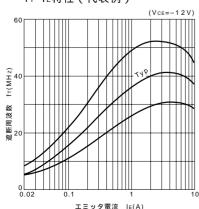
hғ₌−Ic温度特性(代表例)



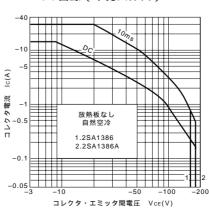
θ_{j-a}-t特性



f⊤−Iε特性(代表例)



ASO曲線(単発パルス)



Pc─Ta定格

